

2025. 9. 24

Micron Technology MU.US

FY4Q25 리뷰 (2) 실적설명회 Q&A 정리

반도체/디스플레이

Analyst 김선우
02. 6454-4862
sunwoo.kim@meritz.co.kr

RA 우서현
02. 6454-4907
seohyun.woo@meritz.co.kr

▶ Micron 실적설명회 주요 Q&A

Q1) 다음분기(FY1Q26) 가이드스 공유 부탁.

A1) 제품 믹스 개선, 원가 절감 노력 등으로 매출총이익률 5.8% 개선 목표. 현재 DRAM 공급은 타이트하고, NAND 큰 폭의 개선세를 보이고 있어 수급 환경 매우 우호적.

수요단에서 견조한 데이터센터 성장세가 예상. 전통 서버 수요 또한 리프 레시와 추론 워크로드 중심으로 성장세. 기존 수요처인 PC, 스마트폰, 전장 모두 DRAM 탑재량이 증가하고 있어 타이트한 공급 상황 지속될 것

Q2) 기존 HBM TAM을 약 1,000억달러로 제시하였는데, 엔비디아, 오픈AI 등은 훨씬 더 큰 수치를 제공. 관련해서 업데이트 부탁.

A2) 당사는 2030년까지 HBM TAM을 1,000억달러로 제시한 바 있으며, 연평균 bit 성장률이 일반 DRAM을 상회할 것으로 전망. 2026년 HBM bit 성장은 전체 DRAM 성장을 당연히 넘어설 것으로 예상.

아울러, 2026년에는 HBM4 전환이 이뤄질 것이며 당사는 11Gbps 이상의 최고 성능 제품군을 잘 준비하고 있음. 데이터센터 인프라 투자 확대가 HBM과 전체 메모리 시장에 막대한 기회 요인임을 확인

Q3) 내년도 HBM3E 가격 전망과 HBM3E, HBM4 크로스오버 예상 시점은?

A3) 가격에 대한 언급은 어려운 점 양해 부탁. 2026년 HBM3E 물량은 대부분의 고객사와 계약 완료. 타이트한 공급 상황이 이어질 것으로 예상되며, DRAM 및 HBM 모두 우호적인 수급 환경 전망.

HBM4는 고객사 일정에 맞춰 생산을 진행할 예정. 2Q26 양산 돌입, 하반기 본격적인 출하 확대 예상

Q4) 다음 분기(FY1Q26) 51.5%의 매출총이익률을 제시했는데, 추가적인 개선이 가능할지?

A4) 1분기에서 2분기로 갈수록 매출총이익률이 개선될 것으로 전망. 이는 1) 타이트한 DRAM 수급 환경, 2) NAND 개선세, 3) 고부가 제품군으로의 bit 전환 및 원가 절감 노력 효과

수요단에서 데이터센터 투자가 계속해서 증가하고 있고, 기존 수요처(서버, 엣지, 전장) 수요 또한 확대되고 있기 때문. 공급단에서는 고객사들의 적정 재고 수준이 지속되고 있으며 동사의 DRAM 재고는 목표치 보다 낮음

DRAM의 타이트한 공급 상황은 D4 생산을 위한 더딘 전환 투자, 그리고 신규 클린룸 증설에 시간과 비용이 많이 들기 때문. 또한, HBM의 높은 집적도로 인한 Capa 잠식 영향 동반

Q5) 추론용 AI 수요의 지속 가능성에 대한 설명 부탁

A5) AI 수요는 학습뿐만 아니라 추론 영역에서 매우 강함. AI 애플리케이션이 확대되고 아키텍처 혁신이 이어지면서 스마트폰 등 엣지 기기 수요 또한 동반 성장. AI 서버가 DRAM 전반의 수요를 크게 견인하고 있으며, HBM, LPDRAM, 고용량 DRAM 모듈 등 다양한 제품군 성장에 기여. 데이터센터, 스마트폰, PC 전반에서 AI가 강력한 수요 견인 역할을 하고 있으며, 2026년 전반에 걸쳐 강한 수요와 타이트한 공급이 예상

Q6) FY2026 Capex 규모가 180억달러로 FY2025 138억달러 대비 증가. 구체적인 사용처 계획은?

A6) 세부 항목별로 공개하지 않지만, 2026년 Capex 대부분은 DRAM에 활용될 것. 시설 투자, 노드 전환용 장비, 신규 그린필드 투자가 포함. 동사는 정부 인센티브를 차감한 순 Capex를 기준으로 제시하고 있으며, 내년도 순 Capex가 180억달러 수준인 점을 다시 한번 공유

2025년 총 158억달러를 집행했고, 미국, 싱가포르, 일본 등에서 약 20억달러의 인센티브를 수령. 앞으로도 유사한 구조로 진행

Q7) 이번 분기말 DRAM 및 전체 재고 수준 전망은?

A7) DRAM 재고는 연중 매우 타이트할 것이고, 목표치보다 낮은 수준을 유지할 것. NAND 역시 시장이 개선되고 있으며, 동사는 절제된 공급 전략을 유지하고 있기 때문에 재고일수는 감소할 것으로 예상.

동사는 고객들과 긴밀히 협력하고 있으며, 공급 상황이 타이트하다는 점을 인지하고 있음. Non-HBM 제품에는 1cnm 공정을 적용하고, HBM은 1bnm를 채택할 계획. 이를 통해 클린룸 공간 활용 극대화, 효율적인 생산 전환 기조 유지할 것

Q8) 일부 고객사에서 더 높은 스펙의 대역폭을 요구하는 것으로 알고 있는데, 이를 대응하기 위해 베이스 다이 설계를 다시 해야했는지?

A8) 동사는 DRAM 다이와 베이스 로직 다이 모두에서 첨단 CMOS 기술을 적용. DRAM 아키텍처 혁신, 메모리 설계, 자체 생산한 CMOS 기반의 베이스 다이 결합을 통해 고객사의 요구 스펙을 충족할 수 있었음. 이를 통해 2.8TB/s 대역폭과 11Gbps 이상의 속도를 구현하며, HBM4 양산 준비 완료

Q9) 2026년 HBM 공급 규모와 추가적인 물량 대응이 가능한지?

A9) 세부적인 공급 물량 공개는 불가. 다만, HBM3E는 이미 2026년 물량 및 가격 계약을 대부분의 고객사와 완료. HBM4 역시 고객사의 스펙 확정과 차세대 플랫폼 계획에 맞춰 수개월 내에 내년도 전체 공급 계약을 마무리할 예정. 동사의 HBM 점유율은 일반 DRAM 점유율과 유사한 수준. HBM은 1bnm를 활용하기 때문에 웨이퍼 조정을 통해 다른 제품군과의 공급 조정을 할 수 있으며, 후공정 투자도 이미 진행돼 있어 충분한 공급 능력을 확보

Q10) HBM4E 표준, 맞춤형 로직다이의 선호도와 생산 유연성에 대한 설명 부탁드립니다.

A10) HBM4E는 2027년에 출시될 제품이며, 표준과 맞춤형 제품 모두 제공할 예정. 베이스 다이 생산에 있어서는 TSMC와 협력할 것. HBM4E의 맞춤형 제품은 더 높은 매출총이익률을 보일 것으로 예상.

2026년 양산하는 HBM4는 동사의 자체 베이스 다이를 기반으로 한다는 점을 다시 한번 강조. 해당 제품은 설계, 아키텍처, 제조 기술 측면에서 경쟁 우위를 제공하고 있음

(자료: Micron 실적설명회)

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.